

公司代码：688729

公司简称：屹唐股份



北京屹唐半导体科技股份有限公司
2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.273元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为2,955,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,686,788.00元（含税）。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	屹唐股份	688729	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单一	阎美芝
联系地址	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号
电话	010-87842689	010-87842689
传真	010-67854899	010-67854899
电子信箱	ir@bestsemi.com	ir@bestsemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。

公司依靠自主研发的核心技术，致力于为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备。公司主要设备相关技术达到国际领先水平，干法去胶设备、快速热处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机，干法刻蚀及等离子体表面处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上，销售收入持续快速增长。

2、主要产品

公司目前主要产品情况如下：

产品系列	图示	应用领域
干法去胶设备		

产品系列	图示	应用领域
Suprema® 系列干法去胶设备		<p>主要用于集成电路芯片制造、芯片封装、微机电系统（MEMS）等领域，用于去除光刻后残余光刻胶，刻蚀后表面清洁、残留物清除、硬掩膜层干法清除等多种干法去胶和干法清除工艺。</p>
Optima® 系列干法去胶设备		<p>主要用于集成电路芯片制造、芯片封装、微机电系统（MEMS）等领域，用于去除光刻后残余光刻胶，刻蚀后表面清洁、残留物清除、硬掩膜层干法清除等多种干法去胶和干法清除工艺。</p>
Hydrilis® HMR 高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备		<p>主要用于集成电路芯片制造中多种硬质掩模材料去除。</p>
快速热处理设备		
Helios® 系列快速热处理设备		<p>广泛应用于逻辑芯片、3D NAND、DRAM、功率半导体、CMOS 图像传感器等器件中快速热处理相关工艺，如离子注入激活和超浅结形成、源漏激活、栅氧修复，金属硅化物形成。</p>

产品系列	图示	应用领域
Millios®闪光毫秒级退火设备		<p>主要应用于逻辑和存储器制造中用于超浅结形成, High k 材料钝化和金属硅化物形成, 也适用于其它材料的表面退火处理。</p>
干法刻蚀及等离子体表面处理设备		
paradigmE® 系列等离子体刻蚀设备		<p>广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中多晶硅、氧化硅、氮化硅刻蚀, 侧墙刻蚀, 金属硅化物阻挡层刻蚀, 抗反射层刻蚀, 自对准双重图形曝光刻蚀, 钝化层刻蚀, 刻蚀后表面处理, 对准标记刻蚀等多种干法刻蚀工艺。</p>
RENA-E® 等离子体刻蚀设备		<p>广泛应用于存储器、逻辑半导体、CMOS 图像传感器制造中叠层(氮化硅, 氧化硅)刻蚀、栓塞回刻(PEB)、钝化层刻蚀、对准标记刻蚀、刻蚀后表面处理、引线孔刻蚀、金属-介质-金属复合钝化层刻蚀等多种干法刻蚀工艺。</p>
Novyka® 系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备		<p>广泛应用于存储器、逻辑半导体、功率 IC 制造中多种材料(多晶硅、氮化硅、氧化硅、金属钨或金属氮化物)的高选择比刻蚀工艺。</p>
Hydrilis® XT 高产能等离子体干法刻蚀设备		<p>半导体制造领域中准关键刻蚀的优选的等离子体干法刻蚀设备。</p>

产品系列	图示	应用领域
Escala®等离子体表面处理和材料改性设备		广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中金属薄膜电阻率降低和金属回流裂缝修复，增强钨薄膜选择性沉积，增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

2.2 主要经营模式

公司结合国家集成电路产业政策、市场发展和供需情况、半导体专用设备行业特点、公司主营业务、主要产品和自身发展阶段等因素，形成了目前的经营模式，经营模式与同行业惯例一致。具体如下：

1、盈利模式

公司主要从事集成电路设备的研发、生产和销售，通过向存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商、功率器件制造厂商等集成电路制造厂商和硅片制造厂商销售干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备，同时提供配件和服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于集成电路设备产品的销售以及设备相关配件销售，提供设备升级维护服务等。

2、研发模式

公司依照行业国际惯例建立产品研发流程及相关制度，对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。公司的新产品研发及商业化流程可以大致分为可行性研究阶段、产品开发及下线阶段、客户端认证阶段、量产及生命周期维护阶段。

公司研发部门包含工程设计和工艺开发团队，分别负责干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备各个产品线包括机械设计、温控与仿真、电气设计、软件设计、工艺开发、新技术开发等各类开发内容。公司建立了科学、规范的研发工作制度，并以市场需求作为技术创新导向，按照多种核心技术、多种产品进行新技术、新工艺、新产品的研发。通过对公司所有研发项目进行立项评审以及验收评审，保证公司研发目标的实现。

3、采购模式

为应对全球半导体供应链波动与地缘政治风险，公司建立了系统、科学的供应链评估与管理体系统。不仅覆盖资质、产能、技术、质量、价格、交期、服务等基础要素，更强化了对关键零部件国产化能力及供应链抗风险指标的量化评估。公司已与全球众多供应商建立了长期稳定的合作关系，确保合格供应商的长期稳定性。同时从需求预测、库存管理、供应商管理三方面进行动态协调，以确保供应稳定的前提下做到成本最优。中国制造基地近年积极推行供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本，做到了供应链整体安全、可控。

4、生产模式

公司采用“客户订单驱动+战略库存驱动”的柔性生产模式，实现精准交付与快速响应的双重优势。客户订单驱动模式下，根据客户采购合同定制化生产，确保产品与需求高度匹配；战略库存驱动模式则针对通用型设备及组件进行前瞻性生产，有效缩短紧急订单交付周期，同时优化产能利用率。两种模式协同运作，既保障了订单交付质量，又提升了市场响应速度。通过对员工进行

多技能培训，对生产场地进行升级改造，打造了柔性化生产线，从而具备快速调整不同产品产能的能力，以快速应对市场需求波动。

5、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司设备销售流程主要包括客户需求调研、技术交流、需求反馈与产品认证、销售洽谈与合同签订、发货、客户验收及售后服务等阶段。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、半导体设备市场规模高速增长

半导体产业作为现代信息技术产业的基石，是支撑数字经济、人工智能、新能源汽车等战略性新兴产业发展的核心基础，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合竞争力的关键指标。受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，根据 WSTS 预测数据，2025 年全球半导体市场规模预计将达到 7,720 亿美元，同比增长 22.5%。展望 2026 年，全球半导体市场规模有望进一步增长至超过 9,750 亿美元，同比增长超过 25%，首次逼近万亿美元大关。

半导体设备是集成电路制造的核心载体，其技术水平直接决定了芯片的制程能力、性能指标和生产良率。随着微观器件越做越小，结构越做越复杂，半导体设备的极端重要性更加凸显出来。半导体设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段。根据 SEMI 的统计数据，全球半导体设备市场（含前端晶圆制造及后端封测设备）在 2025 年达到创纪录的 1,351 亿美元，较 2024 年增长 15.4%；SEMI 预计 2026 年全球半导体设备市场规模将进一步扩大至 1,450 亿美元，同比增长 7.3%。

2、半导体设备行业基本特点及主要技术门槛

半导体行业受国际经济波动、终端消费需求变化等方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。

半导体芯片应用领域极其广泛，既涵盖高性能计算、高端存储器等先进制程芯片需求，也包括电源管理、传感器、汽车电子、显示驱动、MCU、射频前端、功率器件、物联网芯片及工业控制等成熟制程芯片的庞大市场。尽管 AI 驱动下先进制程芯片需求呈爆发式增长，但并未挤压成熟制程芯片的生存空间，两者呈现并行发展态势。据集邦咨询（TrendForce）统计，2023 年中国大陆 28nm 及以上成熟制程半导体制造产能占全球产能份额约 29%，到 2027 年将进一步提升至 33%，成为全球成熟制程半导体制造产能的主要贡献者。

半导体设备价值较高、技术复杂，半导体芯片制造商对于半导体设备的生产效率、良率提升、产品稳定性等方面具有很高的要求，对半导体供应商新设备的验证周期长、替代成本高，因此，半导体设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长，难度较大，产品成功导入客户量产线后客户稳定性也较高。

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。在硬件、软件的支撑之外，半导体设备在客户端不同工艺制程产线上大量应用的过程中，设备厂商长久积累的实际应用经验（know-how）对于其进行产品改进和升级换代以及进一步的技术研发也非常重要，这种隐形的影响因素也进一步提升了半导体设备的研发门槛。随着高端逻辑芯片向 2 纳米及更先进制程迈进、先进存储器芯片向 3D 结构持续演进、先进封装技术等芯片技术

的快速迭代，半导体设备面临着更高的技术挑战与技术创新需求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在半导体设备领域，应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，产品线布局相对完善，并在巩固自身优势基础上积极进行技术升级，占据了绝大部分市场份额。近年来，在中国大陆半导体制造投资浪潮推动下，国内半导体设备行业进入快速发展阶段。

1、干法去胶设备

在先进芯片制造工艺中，对底层材料的保护要求已达到原子级。干法去胶设备技术要求不断提高，干法去胶工艺逐渐成为先进光刻系列工艺中的一道关键步骤，设备应用也不断扩大。

公司的干法去胶设备在全球范围内的集成电路制造产线中具有广泛应用，设备工艺效果优异，具备颗粒污染低、连续生产时间长、大规模量产综合持有成本低等卓越性能，可满足各类制程工艺需求，尤其是在先进逻辑、先进存储及特色工艺芯片制造领域更具有竞争优势。

全球干法去胶设备领域的主要参与者包括 PSK（比思科）、屹唐股份、ULVAC（爱发科）等。根据 Gartner 统计数据，2025 年，干法去胶设备领域前五大厂商的市场份额合计超过 90%，公司凭借 33.7% 的市场占有率位居全球第二，确立了在干法去胶设备细分市场中国际领先的行业地位，公司的去胶设备在国内市场亦占据领先地位。公司开发推出了新一代先进干法去胶设备 Optima[®]，并持续开发新产品，进一步巩固公司在干法去胶设备领域的领先优势。

2、快速热处理设备

近年来，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术越来越受到集成电路制造厂商的关注。随着集成电路性能不断提高的要求，快速热退火技术在晶圆加工/集成电路制造中的竞争优势越来越明显：相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，快速热退火设备只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，总体热预算较低，可以更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求。

公司的常压快速热处理设备采用晶圆双面辐射加热技术，具有温度均匀性好、有效减少晶圆热应力和图形效应、加热速度快、产出高等优势；毫秒级退火设备采用受专利保护的水壁氩气弧灯技术，具有优异的晶圆温度控制能力，独特的脉冲持续时间调整功能和一体式尖峰退火、闪光毫秒级退火功能相结合，提供了广泛的工艺应用。公司的常压快速热处理相关产品覆盖了国内外知名存储芯片、逻辑芯片、功率半导体、硅片制造厂商等领域广泛的客户。

应用材料在全球快速热处理设备领域占据绝对领先地位，根据 Gartner 统计数据，2025 年，应用材料占有的全球快速热处理市场份额达到 57.0%，公司占有的全球快速热处理市场份额为 13.8%，在闪光退火设备领域市场份额位居全球第二。全球快速热处理市场的其他主要参与者包括维易科、科意半导体等。报告期内，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，持续开展多项新型快速热处理设备研发工作，尤其是加速推进低压快速热处理相关设备的研发，进一步扩大可服务市场规模。

3、干法刻蚀及等离子体表面处理设备

干法刻蚀设备是半导体制造中价值量最高的核心设备之一，技术壁垒极高，随着先进制程向 2nm 及以下演进及 3D NAND 堆叠层数持续增加，刻蚀工序数量大幅增加，对刻蚀设备的精度、选择比及产能效率提出了更高要求；先进制程和 3D 结构芯片制造中材料表面质量直接影响器件性能，等离子体表面处理设备通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、DRAM 动态随机存取存储器、3D NAND 闪存等工艺的选择性材料处理及改性等原子层级表面处理，应用场景持续扩大。

公司的刻蚀设备采用电感耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，简称 ICP）技术实现离子能量与密度的独立控制，具备刻蚀速度快、产能高、使用成本低、等离子体损伤低等优势；高选择比刻蚀设备（可刻蚀多晶硅、钨、氮化钛等材料，根据应用气体和刻蚀材料的不同，选择比

最高可达上百比一)、等离子体表面处理设备基于业界领先的远程等离子体与离子辅助控制技术,可满足先进芯片制造中多道尖端刻蚀和原子层级晶圆表面处理要求。公司的干法刻蚀设备和等离子体表面处理相关设备已应用于国内外知名存储芯片和逻辑芯片制造企业客户,销售收入持续快速增长。

全球干法刻蚀设备市场主要由国际巨头主导,根据 Gartner 统计数据,2025年,前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域 82.2%的市场份额,市场格局高度集中。公司是国内为数不多可以量产干法刻蚀设备的厂商,根据 Gartner 统计数据,2025年公司以 0.5%的市场占有率位居全球第九。报告期内,公司推出了新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E®、先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala®,并持续开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发工作,进一步扩大可服务市场规模。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,全球半导体制造产业在人工智能、高性能计算等新兴应用驱动下持续向先进制程演进,对半导体设备的需求量和性能要求同步提升。

1、先进制程、三维结构和先进封装推动设备需求增长

随着芯片制程不断微缩、存储芯片三维堆叠层数持续增加以及先进封装技术的持续演进,半导体制造工序日趋复杂,对设备的需求量显著增长。例如,在存储芯片领域,报告期内,主流 3D NAND 产品堆叠层数已迈向 200 层以上,并向 300 层乃至更高层数演进,层数增加直接导致刻蚀、去胶工序数量大幅增长;高带宽存储器(HBM)通过硅通孔(TSV)技术实现多颗 DRAM 芯片的垂直堆叠,对深硅刻蚀设备的需求持续增长;先进逻辑制程对掺杂激活、高 k 金属栅堆叠、沟道损伤修复的热处理工艺提出原子级精度要求,成为快速热处理设备需求增长的驱动力。

2、先进制程、三维结构和先进封装对设备性能提出更高要求

当前先进制程逻辑芯片制造持续向 2 纳米及以下节点演进,芯片线宽尺寸缩小至原子级,芯片制造精度要求达到前所未有的严苛程度。同时,3D 堆叠技术通过垂直堆叠多层晶体管提升集成度,这一过程大幅增加了制造工艺复杂性。在先进逻辑芯片制造领域,晶体管结构正从 FinFET 向 GAA(全环绕栅极)架构过渡,GAA 晶体管需通过选择性刻蚀精确去除牺牲层以释放纳米线沟道,要求刻蚀精度达到原子级别。原子层刻蚀(ALE)技术通过“表面改性——选择性去除”的循环机制,可实现单原子层的可控刻蚀,成为 GAA 架构芯片制造的关键技术。

先进制程芯片制造对快速热处理设备的热预算控制精度、温度均匀性、热应力管理能力、工艺兼容性等要求愈发严苛。高端快速热处理设备能有效抑制杂质扩散、实现更浅的结深,确保高效退火与掺杂激活,同时严格控制热预算,减少热循环中的应力积累,成为支撑先进逻辑与存储芯片制造的关键工艺设备。

先进制程芯片制造对干法去胶设备的技术水平也提出了更高的要求,先进干法去胶设备需要满足低温工艺和高深宽比结构适应性,原子级清洁度,高选择性去胶的同时不损坏底层材料及器件结构,大规模量产中实现高产能以及低持有成本等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	11,383,768,568.78	9,952,915,308.70	14.38	8,341,075,857.53
归属于上市公司	8,916,417,247.80	5,914,723,200.11	50.75	5,343,142,503.68

股东的净资产				
营业收入	5,076,317,948.58	4,632,977,839.11	9.57	3,931,426,986.51
利润总额	680,426,938.91	512,350,239.97	32.81	264,822,861.19
归属于上市公司股东的净利润	670,779,306.87	540,802,071.81	24.03	309,419,319.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,706,877.18	484,465,205.09	11.61	270,108,346.25
经营活动产生的现金流量净额	-294,917,595.40	682,274,724.36	-143.23	599,573,630.02
加权平均净资产收益率(%)	9.05	9.61	减少0.56个百分点	6.00
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00	0.12
研发投入占营业收入的比例(%)	14.55	15.47	减少0.92个百分点	15.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,159,925,765.82	1,322,053,247.83	1,314,364,013.28	1,279,974,921.65
归属于上市公司股东的净利润	217,565,687.50	130,230,689.16	167,832,879.99	155,150,050.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	139,925,684.88	114,509,782.40	158,242,077.22	128,029,332.68
经营活动产生的现金流量净额	-231,438,984.13	-289,008,558.42	-3,301,600.40	228,831,547.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,897
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,608
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数	

(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京屹唐盛龙半导体产业投资中心(有限合伙)	0	1,198,456,133	40.55	1,198,456,133	无		其他
BEST Holdings #1, LLC	0	262,461,892	8.88	262,461,892	无		境外法人
Oceanpine Marvelous Limited	0	191,752,980	6.49	191,752,980	无		境外法人
天津环旭创芯管理咨询有限公司	0	132,329,530	4.48	132,329,530	无		境内非 国有 法人
江苏招银产业基金管理有限公司—南京招银现代产业壹号股权投资基金(有限合伙)	0	101,141,707	3.42	101,141,707	无		其他
海南鸿道股权投资基金管理有限公司—宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	0	83,226,120	2.82	83,226,120	无		其他
共青城渐升创业投资合伙企业(有限合伙)	0	70,176,263	2.37	70,176,263	无		其他

天津宸辉私募基金管理有限公司一天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	0	66,580,895	2.25	66,580,895	无	其他
红杉鹏辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	53,264,716	1.80	53,264,716	无	其他
BEST Holdings #2, LLC	0	52,132,842	1.76	52,132,842	无	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	环旭创芯的实际控制人陈立庚和海松非凡的实际控制人陈立光为兄弟关系。BH1、BH2 为公司员工持股平台。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

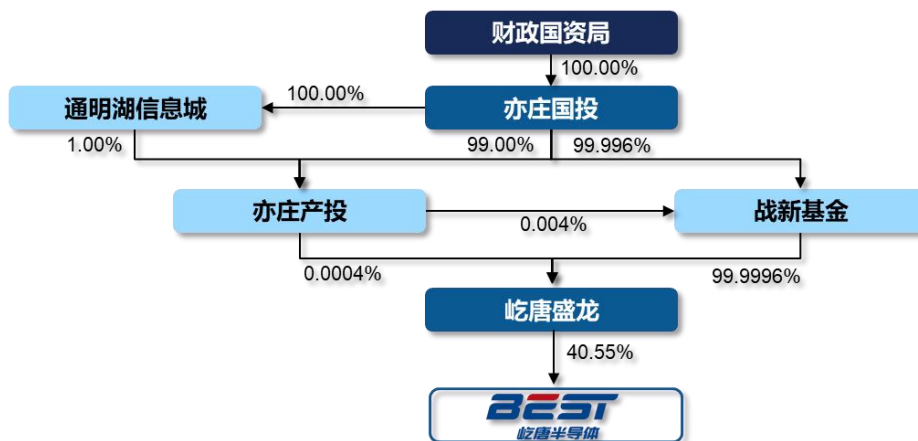
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”之“（一）报告期内主要经营情况”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用